

N-沟道功率 MOS 管/ N-CHANNEL POWER MOSFET

SIF2N65F

- 特点：热阻低 开关速度快 输入阻抗高 符合RoHS规范
- FEATURES: ■LOW THERMAL RESISTANCE ■FAST SWITCHING ■HIGH INPUT RESISTANCE
■RoHS COMPLIANT
- 应用：电子镇流器 电子变压器 开关电源
- APPLICATION: ■ELECTRONIC BALLAST ■ELECTRONIC TRANSFORMER ■SWITCH MODE POWER SUPPLY

●最大额定值 (TC=25°C)

●Absolute Maximum Ratings (Tc=25°C) TO-251T/251S/252/252T

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	额定值 VALUE	单位 UNIT
漏-源电压 Drain-source Voltage	V _{DS}	650	V
栅-源电压 gate-source Voltage	V _{GS}	±30	V
漏极电流 Continuous Drain Current TC=25°C	I _D	2.0*	A
漏极电流 Continuous Drain Current TC=100°C	I _D	1.25*	A
最大脉冲电流 Drain Current – Pulsed ①	I _{DM}	8*	A
耗散功率 Power Dissipation	P _{tot}	44	W
最高结温 Junction Temperature	T _j	150	°C
存储温度 Storage Temperature	T _{STG}	-55-150	°C
单脉冲雪崩能量 Single Pulse Avalanche Energy ②	E _{AS}	120	mJ

V_{DS}=650V
R_{DS(ON)}=4.5Ω
I_D=2.0A

TO-251T(IPAK) TO-251S
TO-252(DPAK) TO-252T

*漏极电流由最高结温限制

*Drain current limited by maximum junction temperature

●电特性 (Tc=25°C)

●Electronic Characteristics (Tc=25°C)

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	测试条件 TEST CONDITION	最小值 MIN	典型值 TYP	最大值 MAX	单位 UNIT
漏-源击穿电压 Drain-source Breakdown Voltage	BV _{DSS}	V _{GS} =0V, I _D =250μA	650			V
击穿电压温度系数 Breakdown Voltage Temperature Coefficient	ΔBV _{DSS} /ΔT _j	I _D =250uA, Referenced to 25°C		0.6		V/°C
栅极开启电压 Gate Threshold Voltage	V _{GS(TH)}	V _{GS} =V _{DS} , I _D =250μA	2.0		4.0	V
漏-源漏电流 Drain-source Leakage Current	I _{DSS}	V _{DS} =650V, V _{GS} =0V, T _j =25°C			1	μA
		V _{DS} =520V, V _{GS} =0V, T _j =125°C			100	μA
跨导 Forward Transconductance	g _{fs}	V _{DS} =40V, I _D =1.0A ③		1.5		S

●订单信息/ORDERING INFORMATION:

包装形式/PACKING	订货编码/ORDERING CODE	
	普通塑封料 Normal Package Material	无卤塑封料 Halogen Free
TO-252(T)或 251T 或 251S 条管装 TUBE PACKING	SIF2N65F TO-251T-TU 或 TO-251S-TU 或 TO-252(T)-TU	SIF2N65F TO-251T-TU-HF 或 TO-251S-TU-HF 或 TO-252(T)-TU-HF
TO-252(T) 编带装/TAPE & REEL PACKING	SIF2N65F TO-252(T)-TR	SIF2N65F TO-252(T)-TR-HF

N-沟道功率 MOS 管/ N-CHANNEL POWER MOSFET

SIF2N65F

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	测试条件 TEST CONDITION	最小值 MIN	典型值 TYP	最大值 MAX	单位 UNIT
栅极漏电流 Gate-body Leakage Current ($V_{DS} = 0$)	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 30V$			± 100	nA
漏-源导通电阻 Static Drain-source On Resistance	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS} = 10V, I_D = 1.0A$ ③		4.5	5.5	Ω
输入电容 Input Capacitance	C_{iss}	$V_{GS} = 0V, V_{DS} = 25V$ $F = 1.0MHz$		290		pF
输出电容 Output Capacitance	C_{oss}			31		
反向传输电容 Reverse transfer Capacitance	C_{rss}			9		
关断延迟 Turn -Off Delay Time	$T_d(off)$	$V_{DD} = 325V, I_D = 2.0A$ $R_G = 25\Omega$ ③		24		ns
栅极电荷 Total Gate Charge	Q_g	$I_D = 2.0A, V_{DS} = 520V$ $V_{GS} = 10V$ ③		6.7		nC
栅源电荷 Gate-to-Source Charge	Q_{gs}			1.9		nC
栅漏电荷 Gate-to-Drain Charge	Q_{gd}			1.8		nC
二极管正向电流 Continuous Diode Forward Current	I_s				2.0	A
二极管正向压降 Diode Forward Voltage	V_{SD}	$T_j = 25^\circ C, I_s = 2.0A$ $V_{GS} = 0V$ ③			1.4	V
反向恢复时间 Reverse Recovery Time	t_{rr}	$T_j = 25^\circ C, I_f = 2.0A$ $di/dt = 100A/\mu s$ ③		368		ns
反向恢复电荷 Reverse Recovery Charge	Q_{rr}			1.0		μC

●热特性

●Thermal Characteristics

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	最大值 MAX	单位 UNIT
热阻结-壳 Thermal Resistance Junction-case	R_{thJC}	2.84	$^\circ C/W$
热阻结-环境 Thermal Resistance Junction-ambient	R_{thJA}	62.5	$^\circ C/W$

注释(Notes):

① 脉冲宽度：以最高节温为限制

Repetitive rating: Pulse width limited by maximum junction temperature

② 初始结温= $25^\circ C$, $V_{DD} = 50V$, $L = 56mH$, $R_G = 25\Omega$, $I_{AS} = 2.0A$

Starting $T_j = 25^\circ C$, $V_{DD} = 50V$, $L = 56mH$, $R_G = 25\Omega$, $I_{AS} = 2.0A$

③ 脉冲测试：脉冲宽度 $\leq 300\mu s$ ，占空比 $\leq 2\%$

Pulse Test : Pulse width $\leq 300\mu s$, Duty cycle $\leq 2\%$

N-沟道功率 MOS 管/ N-CHANNEL POWER MOSFET

SIF2N65F

● 特性曲线

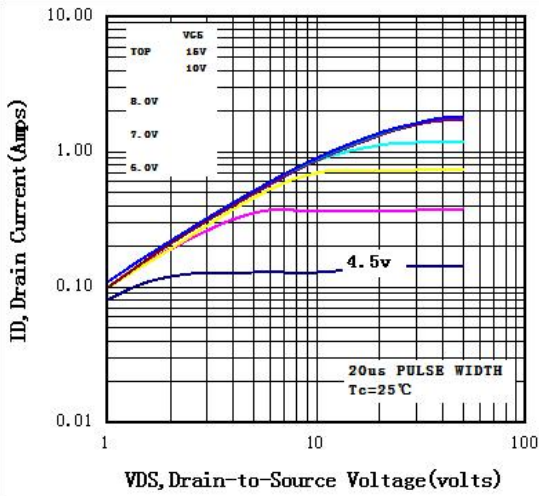


图 1 输出特性曲线, Tc=25°C

Fig1 Typical Output Characteristics, Tc=25°C

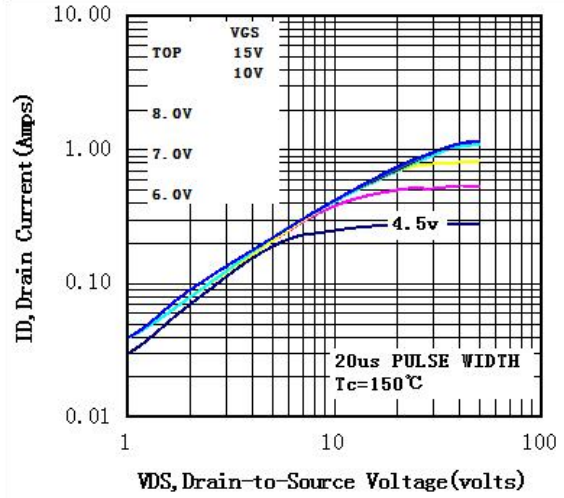


图 2 输出特性曲线, Tc=150°C

Fig2 Typical Output Characteristics, Tc=150°C

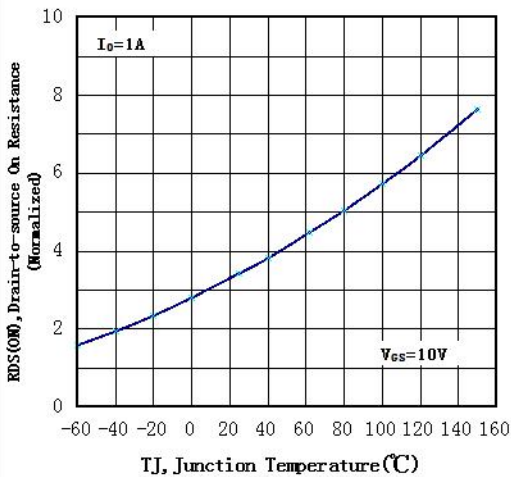


图 3 导通电阻与温度曲线

Fig3 Normalized On-Resistance Vs. Temperature

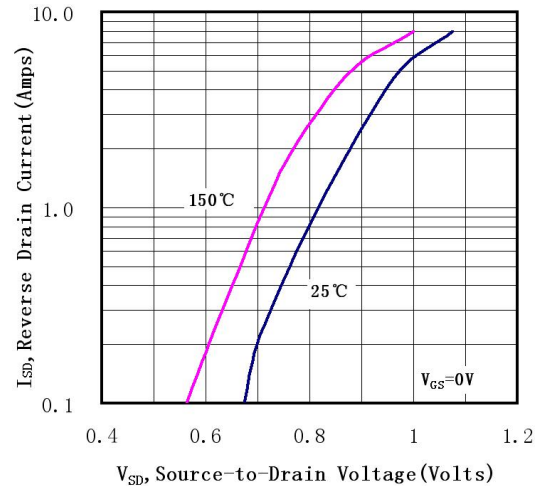


图 4 二极管正向电压曲线

Fig4 Typical Source-Drain Diode Forward Voltage

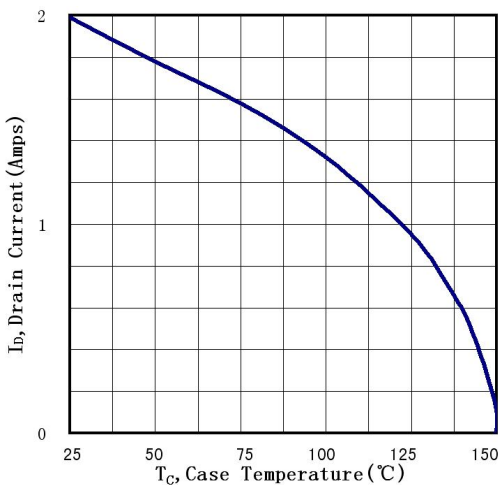


图 5 最大漏极电流与壳温曲线

Fig5 Maximum Drain Current Vs. Case Temperature

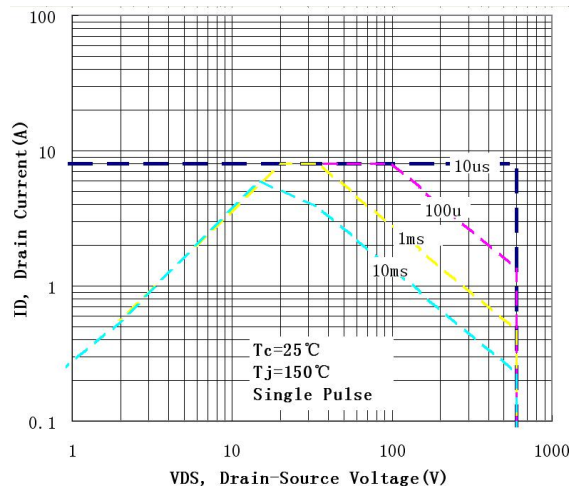


图 6 最大安全工作区曲线

Fig6 Maximum Safe Operating Area

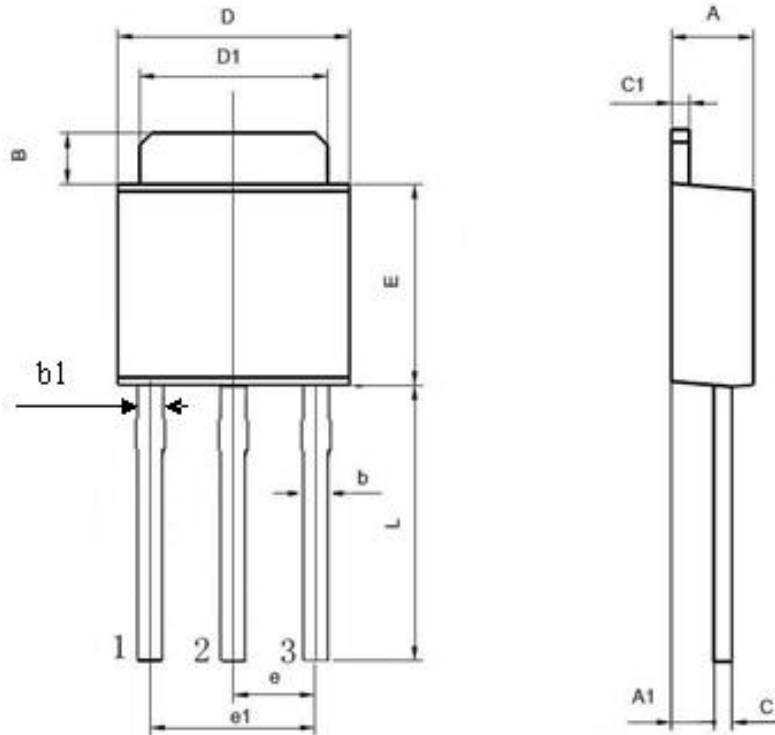


TO-251T 封装机械尺寸
TO-251T (IPAK) MECHANICAL DATA

单位:毫米/UNIT: mm

符号/SYMBOL	最小值/min	典型值/nom	最大值/max
A	2.10		2.50
A ₁	0.95		1.30
B	0.80		1.25
b	0.50		0.80
b ₁	0.70		0.80
c	0.45		0.70
c ₁	0.45		0.70
D	6.35		6.80
D ₁	5.10		5.50
E	5.30		6.30
e	2.25	2.30	2.35
L	7.00		9.20
H	0.35		0.45
W1	0.30		0.50
W2	0.20		0.40

[S/L]

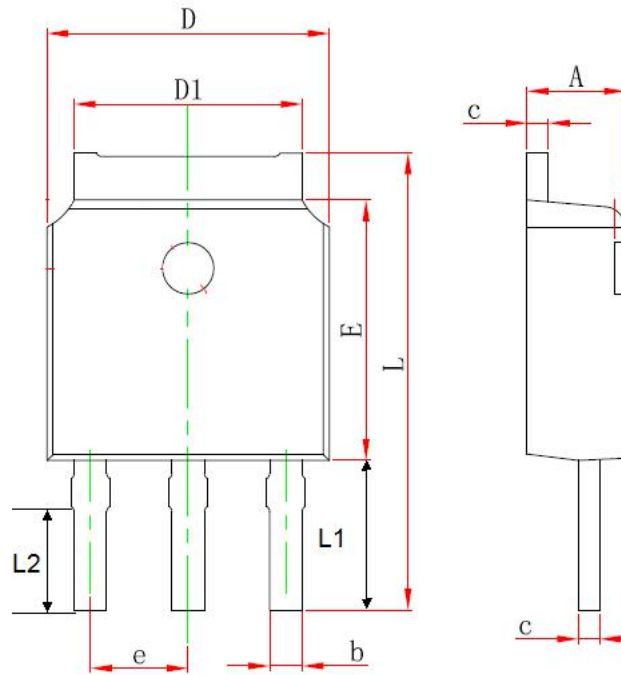




TO-251S 封装机械尺寸 TO-251S (IPAK) MECHANICAL DATA

单位:毫米/UNIT: mm

符号/SYMBOL	最小值/min	典型值/nom	最大值/max
A	2.20		2.40
b	0.50		0.85
C	0.45	0.50	0.60
D	6.50		6.70
D1	5.10		5.50
E	5.9		6.20
e	2.18	2.29	2.38
L	11.00		12.40
L1	4.8		5.3
L2	3.5		4.2

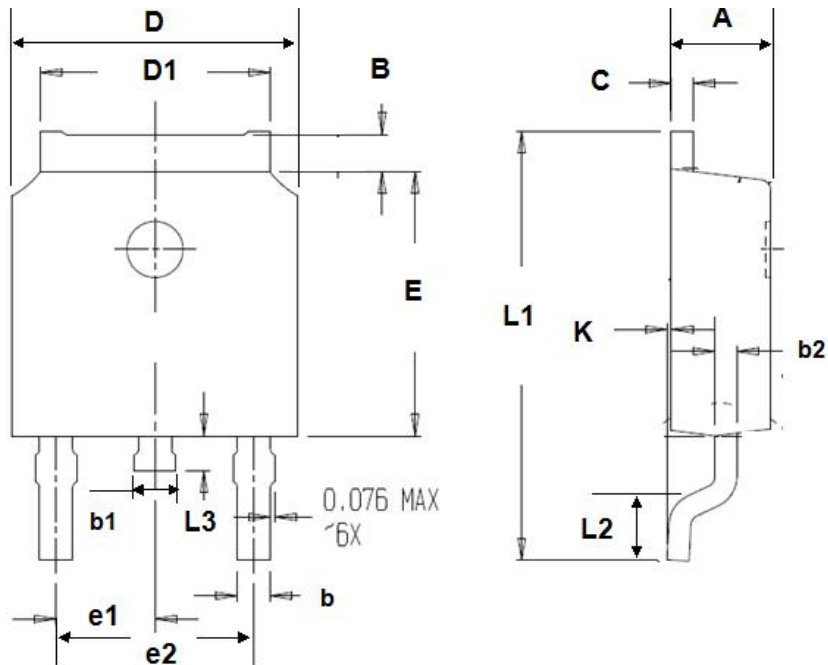




TO-252 封装机械尺寸
TO-252 MECHANICAL DATA

单位:毫米/UNIT: mm

符号 SYMBOL	最小值 min	最大值 max	符号 SYMBOL	最小值 min	最大值 max
A	2.10	2.50	B	0.85	1.25
b	0.50	0.80	b1	0.70	1.20
b2	0.45	0.70	C	0.45	0.70
D	6.30	6.75	D1	5.10	5.50
E	5.30	6.30	e1	2.25	2.35
L1	9.20	10.60	e2	4.45	4.75
L2	0.90	1.75	L3	0.60	1.10
K	0.00	0.23			

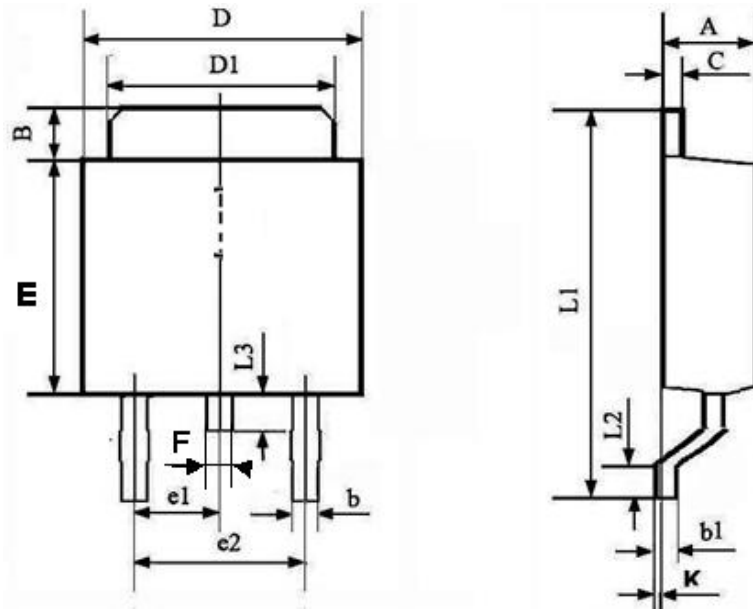




TO-252T 封装机械尺寸 TO-252T MECHANICAL DATA

单位:毫米/UNIT: mm

符号 SYMBOL	最小值 min	最大值 max	符号 SYMBOL	最小值 min	最大值 max
A	2.20	2.40	B	0.85	1.25
b	0.50	0.80	C	0.45	0.70
b1	0.45	0.70	D	6.30	6.70
D1	5.10	5.50	E	5.30	6.20
L1	9.20	10.60	F	0.50	0.90
L2	0.90	1.50	e1	2.25	2.35
L3	0.60	1.10	e2	4.50	4.70
			K	0.00	0.18



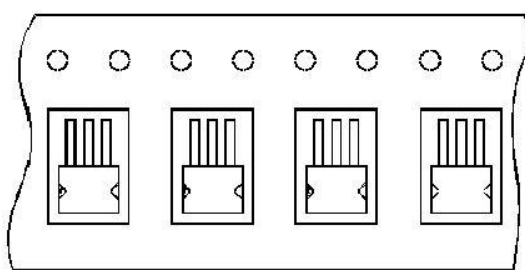
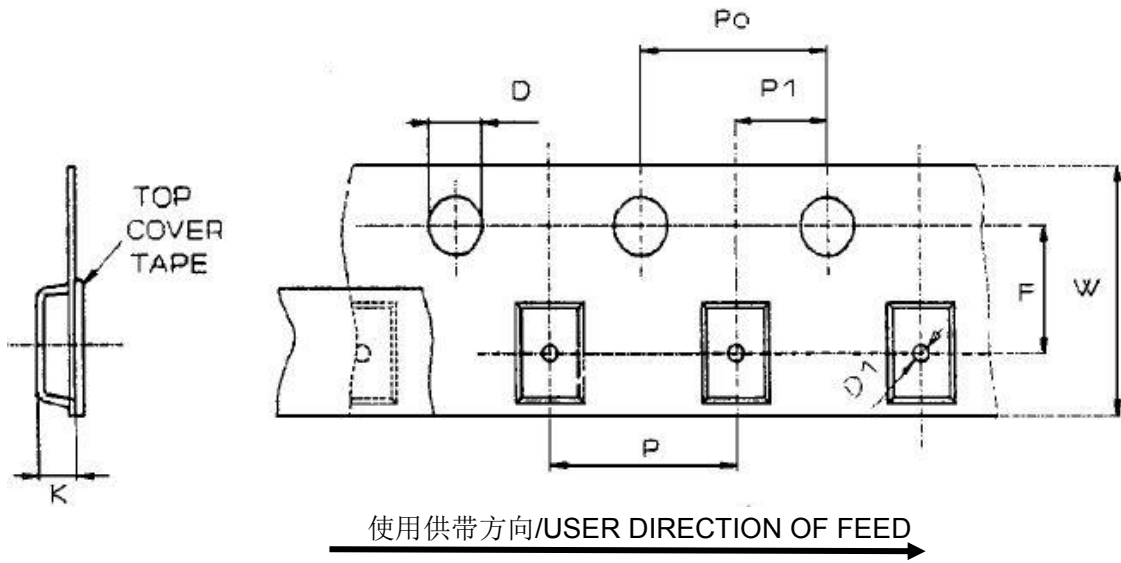
[L]



TO-252 编带规格尺寸 TO-252 TAPE AND REEL DATA

单位:毫米/UNIT: mm

符号 SYMBOL	最小值 min	最大值 max	符号 SYMBOL	最小值 min	最大值 max
W	16.0-0.3	16.0+0.3	F	7.5-0.1	7.5+0.1
P0	4.0-0.1	4.0+0.1	D	1.5-0.0	1.5+0.1
P	8.0-0.1	8.0+0.1	P1	2.0-0.1	2.0+0.1
K	2.65	2.80	D1	1.5-0.0	1.5+0.1



编带器件定位/UNIT ORIENTATION

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [MOSFET](#) category:

Click to view products by [SI manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[614233C](#) [648584F](#) [IRFD120](#) [IRFF430](#) [JANTX2N5237](#) [2N7000](#) [FCA20N60_F109](#) [FDZ595PZ](#) [AOD464](#) [2SK2267\(Q\)](#) [2SK2545\(Q,T\)](#)
[405094E](#) [423220D](#) [MIC4420CM-TR](#) [VN1206L](#) [614234A](#) [715780A](#) [SSM6J414TU,LF\(T](#) [751625C](#) [PSMN4R2-30MLD](#)
[TK31J60W5,S1VQ\(O](#) [2SK2614\(TE16L1,Q\)](#) [DMN1017UCP3-7](#) [EFC2J004NUZTDG](#) [FCAB21350L1](#) [P85W28HP2F-7071](#) [DMN1053UCP4-7](#)
[NTE2384](#) [NTE2969](#) [NTE6400A](#) [DMN2080UCB4-7](#) [DMN61D9UWQ-13](#) [US6M2GTR](#) [DMN31D5UDJ-7](#) [SSM6P54TU,LF](#) [DMP22D4UFO-](#)
[7B](#) [IPS60R3K4CEAKMA1](#) [DMN1006UCA6-7](#) [DMN16M9UCA6-7](#) [STF5N65M6](#) [STU5N65M6](#) [C3M0021120D](#) [DMN13M9UCA6-7](#)
[BSS340NWH6327XTSA1](#) [MCM3400A-TP](#) [DMTH10H4M6SPS-13](#) [IRF40SC240ARMA1](#) [IPS60R1K0PFD7SAKMA1](#)
[IPS60R360PFD7SAKMA1](#) [IPS60R600PFD7SAKMA1](#)